承 诺 书
此文章不涉苔且不存在造假，抄袭，一稿多投等学术不端行州，特此承诺。

第一（通订）作者签学：莗海多 2024年2月27日

《中国光学（中英文）》编辑部：
者（需按正式发表文章㗊名顺序，填写全部作者姓名）为你刊揌写的文章 Effect of GaInp and GaASP inserted into waveguide／barrier （题目：－interface on carrier leakage in InslGals quantum well 808 nm laser diode．经审直，未必现该义索存在涉密内容和造假，抄著，一稿多投等学术不端现象。该文章若存在涉密内容和造假，抄袭，一稿多投等学术不端问题，《中困光学（中英文）》偳轻部无需承担任何责任。该文章一经录用，共数字化贾制权，发行权，汇编权及信息网络传播权将转让予《中国光学（中英文）》编辑部。


